

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich
Vergleichbarer Typ: BD 135, BD 137, BD 139

Application: General in AF-range
Comparable type: BD 135, BD 137, BD 139

Besondere Merkmale:

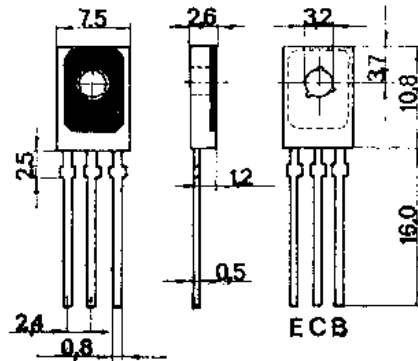
- Verlustleistung 12,5 W
- Gepaart lieferbar
- SD 335, SD 337, SD 339 sind komplementär zu SD 336, SD 338, SD 340

Features:

- Power dissipation 12,5 W
- Matched pairs available
- SD 335, SD 337, SD 339 are complementary to SD 336, SD 338, SD 340

Abmessungen in mm

Dimensions in mm



Kollektor mit metallischer Montagefläche verbunden
Gehäuse Bauform N, ähnlich SOT 32
TGL 11 811
Plastgehäuse
Masse ca. 0,75 g

Collector connected with metallic surface
Case construction N, similar SOT 32
TGL 11 811
Plastic case
Weight about 0.75 g

Absolute Grenzwerte

Absolute maximum ratings

		SD 335	SD 337	SD 339	
Kollektor-Basis-Spannung Collector-base voltage	U_{CBO}	45	60	80	V
Kollektor-Emitter-Spannung Collector-emitter voltage	U_{CEO}	45	60	80	V
Emitter-Basis-Spannung Emitter-base voltage	U_{EBO}		5		V
Kollektorstrom Collector current	I_C		1,5		A
Kollektorspitzenstrom Collector peak current	I_{CM}		2		A
Basisstrom Base current	I_B		0,2		A

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
 $t_c \leq 25^\circ\text{C}$
 $t_{amb} \leq 40^\circ\text{C}$

Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

	Min.	Typ.	Max.	
P_{tot}		12,5		W
P_{tot}		1		W
t_j		150		$^\circ\text{C}$
t_{amb}	-55 ...		+125	$^\circ\text{C}$
t_{stg}	-55 ...		+150	$^\circ\text{C}$

Wärmewiderstände Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction-ambient
Sperrschicht-Gehäuse
Junction-case

	Min.	Typ.	Max.	
R_{thJA}			110	K/W
R_{thJC}			10	K/W

Statische Kenngrößen

DC characteristics $t_{amb} = 25^\circ\text{C} \pm 5\text{K}$

Kollektor-Basis-Reststrom
Collector cut-off current
 $U_{CB} = 30\text{V}$

I_{CBO}	< 1	100	nA
-----------	-----	-----	----

Kollektor-Emitter-Reststrom
Collector cut-off current
 $U_{CE} = 45\text{V}$
 $U_{CE} = 60\text{V}$
 $U_{CE} = 80\text{V}$

SD 335	I_{CEO}	< 5	nA
SD 337	I_{CEO}	< 5	nA
SD 339	I_{CEO}	< 5	nA

Emitter-Basis-Reststrom
Emitter cut-off current
 $U_{EB} = 5\text{V}$

I_{EBO}	< 5 nA	10	μA
-----------	--------	----	---------------

Kollektor-Emitter-Reststrom
Collector cut-off current
 $R_{BE} = 1\text{k}\Omega$
 $U_{CE} = 45\text{V}$
 $U_{CE} = 60\text{V}$
 $U_{CE} = 80\text{V}$

SD 335	I_{CER}	< 1	nA
SD 337	I_{CER}	< 1	nA
SD 339	I_{CER}	< 1	nA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
 $I_C = 1\text{mA}$

SD 335	$U_{(BR)CBO}$	45	V
SD 337	$U_{(BR)CBO}$	60	V
SD 339	$U_{(BR)CBO}$	80	V

